

Silicon Diode

BYT77

800V / 3A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BYT 77 · BYT 78

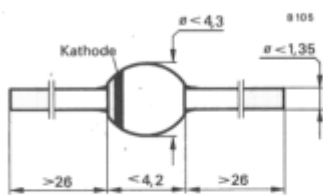
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller "soft recovery" Gleichrichter

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

Bestemp lung: Klartext

Absolute Grenzdaten

		BYT 77	BYT 78	
Sperrspannung	U_R	800	1000	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	100		A
Durchlaßstrom, Mittelwert $T_{amb} \leq 45 \text{ °C}$	Fig. 2, 5 I_{FAV}	3		A
Sperrschichttemperatur	T_j	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65... + 175		°C

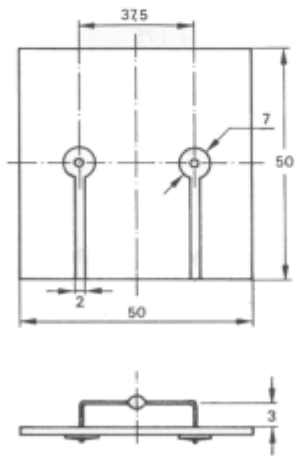
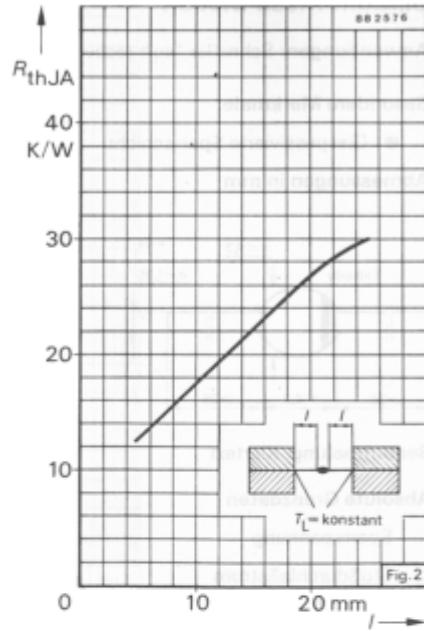
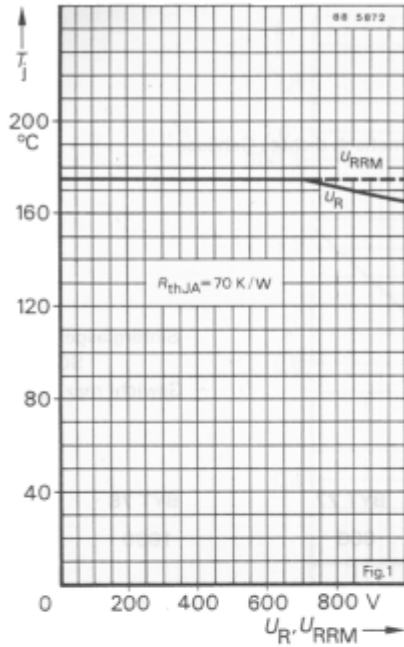
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung				
$l = 25 \text{ mm}$, $T_L = \text{konstant}$ auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	Fig. 2	R_{thJA}	30	K/W
	Fig. 3	R_{thJA}	70	K/W

Kenngrößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 3 \text{ A}$	U_F		1,0	1,1	V
Sperrstrom					
U_R	I_R		1	5	μA
$U_{R'} T_j = 150 \text{ °C}$	I_R		60	150	μA
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5 \text{ A}$, $I_R = 1 \text{ A}$, $i_R = 0,25 \text{ A}$	t_{rr}			300	ns

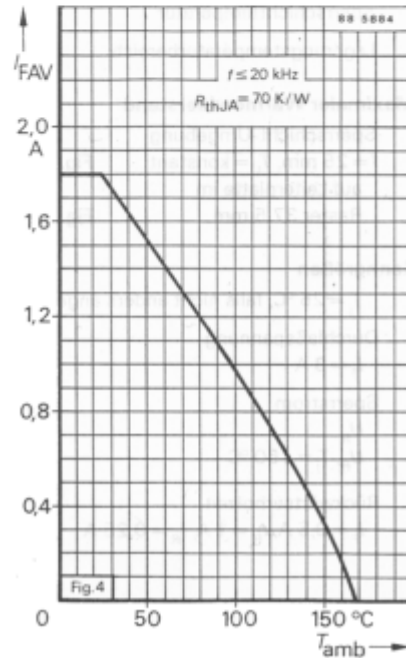
BYT 77 · BYT 78



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 70 \text{ K/W}$

Fig.3

88 5875



BYT 77 · BYT 78

